

2Т602Б

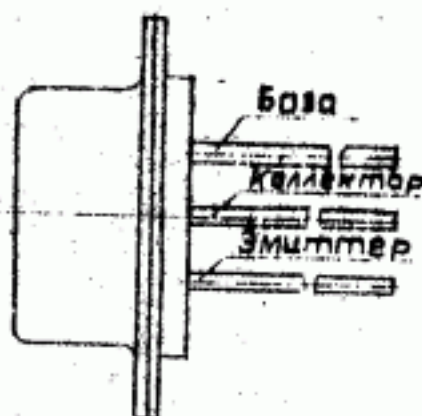
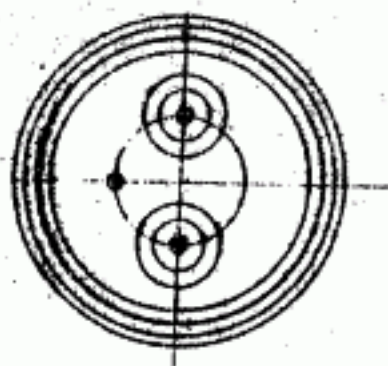
50

ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ  
2Т602А, 2Т602Б

## ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы 2Т602А, 2Т602Б в металлостеклянном корпусе, предназначенные для генерирования и усиления сигналов в радиотехнических устройствах специального назначения.

Климатическое исполнение УХЛ.



Масса не более 5 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ  $t_{\text{окр. ср.}} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$

| Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)                                                                                                                                                                                 | Буквенное обозначение | Н о р м а |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 2Т602А    |          | 2Т602Б   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                       | не менее  | не более | не менее | не более |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 2                     | 3         | 4        | 5        | 6        |
| Обратный ток коллектора, мкА<br>( $U_{\text{КБ}} = 120 \text{ В}$ );<br>( $U_{\text{КБ}} = 100 \text{ В}$ , $t_{\text{окр. ср.}} = (+125 \pm 5)^\circ\text{C}$ )                                                                             | $I_{\text{КБ0}}$      |           | 10<br>50 |          | 10<br>50 |
| Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА<br>( $U_{\text{КЭ}} = 100 \text{ В}$ , $R_{\text{БЭ}} = 10 \text{ Ом}$ );<br>( $U_{\text{КЭ}} = 80 \text{ В}$ , $R_{\text{БЭ}} = 10 \text{ Ом}$ при $t_{\text{окр. ср.}} = (+125 \pm 5)^\circ\text{C}$ ) | $I_{\text{КЭР}}$      |           | 10<br>50 |          | 10<br>50 |
| Обратный ток эмиттера, мкА<br>( $U_{\text{ЭВ}} = 5 \text{ В}$ )                                                                                                                                                                              | $I_{\text{ЭВ0}}$      |           | 50<br>50 |          | 50<br>50 |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером<br>( $U_{\text{КБ}} = 10 \text{ В}$ , $I_{\text{Э}} = 10 \text{ мА}$ )                                                                                                       | $h_{21Э}$             | 20        | 80       | 50       | 200      |
| Емкость коллекторного перехода, пФ<br>( $U_{\text{КБ}} = 50 \text{ В}$ , $f = 5 \text{ МГц}$ )                                                                                                                                               | $C_{\text{к}}$        |           | 4        |          | 4        |
| Емкость эмиттерного перехода, пФ<br>( $U_{\text{ЭВ}} = 0$ , $f = 5 \text{ МГц}$ )                                                                                                                                                            | $C_{\text{э}}$        |           | 25       |          | 25       |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В<br>( $I_{\text{К}} = 50 \text{ мА}$ , $I_{\text{Б}} = 5 \text{ мА}$ )                                                                                                                              | $U_{\text{КЭнас}}$    |           | 3        |          | 3        |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, В<br>( $I_{\text{К}} = 50 \text{ мА}$ , $I_{\text{Б}} = 5 \text{ мА}$ )                                                                                                                                   | $U_{\text{БЭнас}}$    |           | 3        |          | 3        |
| Граничное напряжение, В<br>( $I_{\text{Э}} = 50 \text{ мА}$ , $f = 2 \text{ кГц}$ , $\tau_{\text{и}} = 5 \text{ мкс}$ )                                                                                                                      | $U_{\text{КЭ0гр}}$    | 70        |          | 70       |          |
| Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, пс<br>( $U_{\text{КБ}} = 10 \text{ В}$ , $I_{\text{К}} = 10 \text{ мА}$ , $f = 5 \text{ МГц}$ )                                                                                   | $\tau_{\text{к}}$     |           | 300      |          | 300      |

| 1                                                                                                          | 2           | 3   | 4 | 5   | 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---|-----|---|
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте<br>( $U_{КЭ} = 10В$ , $I_K = 25 мА$ , $f = 100 МГц$ ) | $ h_{21э} $ | 1,5 |   | 1,5 |   |

Содержание драгоценных металлов в 1000шт. транзисторов:

золото - 17,7644 г

в том числе золото 0,00003030 г/мм на 3 выводах длиной  $32 \pm 2$  мм.

Содержание цветных металлов в одном транзисторе

медь - 1,6 г. в колпаке и ножке.

# СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т602А, 2Т602Б соответствует техническим условиям 3.365.000ТУ.

172 19 АПР 1989

Приняты по извещению №

от

УПАКОВЩИК №4

дата

АПР 1989

ШТАММ ОТК

ШТАМП

ОТК209

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Перепроверка произведена

дата

36

Приняты по извещению №

от

дата

ШТАММ ОТК

ШТАМП

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА